Эффективные заряды атомов и процессы переноса заряда в решетках сверхпроводников

© В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, Н.П. Серегин, П.П. Серегин

Санкт-Петербургский государственный технический университет, 195251 Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 21 января 1997 г. В окончательной редакции 12 мая 1997 г.)

Определены эфективные заряды атомов для решеток соединений RBa₂Cu₃O₇ (R — иттрий или редкоземельный металл), Tl₂Ba₂Ca₂Cu₃O₁₀ и Bi_{1.6}Pb_{0.4}Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀. Показано, что в RBa₂Cu₃O₇ дырки делокализованы преимущественно в подрешетке цепочечного кислорода. Предложены две модели распределения зарядов в решетках соединений Tl₂Ba₂Ca₂Cu₃O₁₀ и Bi_{1.6}Pb_{0.4}Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀, которые предполагают наличие дырок на кислородных узлах в плоскости Cu(2)–O, но отличаются заполненностью 3*d*-оболочки меди в узлах Cu(1). Не исключается, что заряды атомов Tl, Bi и Cu(1) в двух последних решетках могут быть управляемыми. Продемонстрировано качественное согласие полученных результатов с результатами холловских измерений концентрации дырок и ее температурной зависимости в исследованных соединениях.

Информация о величинах зарядов атомов в кристаллических решетках высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) важна как для теоретического описания сверхпроводящего состояния в них, так и для начальной интерпретации многих экспериментальных данных. Одним из наиболее эффективных методов их определения является сравнение расчетных и экспериментально определенных параметров тензора градиента электрического поля (ГЭП). Полученные результаты наиболее убедительны, а их интерпретация наглядна, если в эксперименте используются "кристаллические" зонды, т.е. зонды, для которых ГЭП создается только ионами кристаллической решетки, поскольку в этом случае расчет тензора ГЭП можте быть проведен в рамках апробированной модели точечных зарядов. В частности, для соединения YBa₂Cu₃O₇ (YBaCuO) методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии (ЭМС) ⁶⁷Сu(⁶⁷Zn) с помощью кристаллического зонда ⁶⁷Zn²⁺ нами были измерены параметры тензора кристаллического ГЭП в узлах меди, рассчитаны эти параметры в приближении точечных зарядов и на основе сравнения экспериментальных и расчетных параметров определены эффективные заряды атомов [1]. Однако в [1] остались открытыми вопросы, касающиеся однозначности выбора модели распределения зарядов по узлам решетки и возможности согласования полученных распределений зарядов с результатами исследований явлений переноса заряда в YBa₂Cu₃O₇. Кроме того, реализованная в [1] методика не является универсальной, поскольку для большинства ВТСП число доступных экспериментальных параметров, получаемых из ЭМС ⁶⁷Cu(⁶⁷Zn), значительно уступает числу определяемых зарядов. В этом случае необходимо привлекать данные по параметрам ГЭП, полученным методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР). Однако здесь возникает проблема противоречивости данных ЯМР и ЯКР: типичными примерами являются результаты исследований соединений $Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}$ (TlBaCaCuO) [2,3] и $Bi_{1.6}Pb_{0.4}Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$ (BiSrCaCuO) [3–7] методами ЯМР и ЯКР 63 Си.

Очевидно, что для решения всех перечисленных проблем необходимо установить корреляции между данными по параметрам ГЭП, полученным различными экспериментальными методами. В настоящей работе на основе таких корреляций предлагаются модели пространственного распределения дырок в решетках RBa₂Cu₃O₇ (RBaCuO) (*R* — иттрий или редкоземельный металл (РЗМ)), TlBaCaCuO и BiSrCaCuO, описывающие зарядовые (валентные) состояния атомов и механизмы переноса носителей заряда в этих структурах, а также объясняющие противоречивость данных ЯМР и ЯКР для соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO. Общей особенностью всех указанных соединений является существование в их структуре двух состояний атомов меди, и полученные результаты указывают на различную роль этих состояний.

1. Расчет параметров тензора кристаллического ГЭП

Для расчета тензора кристаллического ГЭП решетки исследованных ВТСП представлялись в виде суперпозиции нескольких подрешеток:

 $RBa_2Cu(1)Cu(2)_2O(1)_2O(2)_2O(3)_2O(4),$

Tl₂Ba₂Ca₂Cu(1)Cu(2)₂O(1)₂O(2)₄O(3)₂O(4)₂,

 $(Bi_{1.6}Pb_{0.4})Sr_2Ca_2Cu(1)Cu(2)_2O(1)_2O(2)_2O(3)_2O(4)_2O(5)_2.$

Для соединений RBaCuO атомы O(1) являются мостиковыми, атомы O(2), O(3) — плоскостными, O(4) — цепочечными, для соединения TlBaCaCuO атомы O(2) находятся в одной плоскости с атомами Cu(2), для соединения BiSrCaCuO атомы O(2) и O(3) находятся в одной плоскости с атомами Cu(2). При расчетах использовались структурные данные [8–10].

Эффективные заряды атомов решеток RBaCuO

В общем случае измеренная величина постоянной квадрупольного взаимодействия $C = e Q U_{zz} / h$ представляет собой сумму двух членов

$$eQU_{zz} = eQ(1-\gamma)V_{zz} + eQ(1-R_o)W_{zz},$$
 (1)

где U_{zz} , V_{zz} , W_{zz} — главные компоненты тензоров суммарного, кристаллического и валентного ГЭП, γ , R_0 — коэффициенты Штернхеймера атома-зонда, eQ — квадрупольный момент ядразонда.

Для зонда ${}^{67}Zn^{2+}$ вкладом в тензор суммарного ГЭП от валентных электронов можно пренебречь

$$C(\mathrm{Zn}) \approx eQ(1-\gamma)V_{zz}/h, \qquad (2)$$

и для определения эффективных зарядов атомов могут быть использованы уравнение электронейтральности, уравнения для параметров асимметрии тензоров ГЭП η и уравнения для отношения главных компонент тензоров ГЭП двух неэквивалентных узлов, занятых атомами одной химической природы. Все эти уравнения однородные, и поэтому составленная из них система может определить заряды атомов лишь в единицах заряда одного из них. В качестве такого заряда удобно выбрать заряд ионов R, который следует ожитдать близким к +3e. Это подтверждается данными мессбауэровской спекроскопии [11].

Физический смысл эффективных зарядов e_k^* , полученных в качестве решения системы уравнений, достаточно очевиден: это те заряды, которые требуются для описания электрического поля ионов с помощью кулоновского потенциала. Однако заряды e_k^* не следует рассматривать как точные значения электрических зарядов ионов в узлах кристаллической решетки: во-первых, масштаб заряда устанавливается достаточно произвольно через заряд редкоземельных ионов; вовторых, уравнения основаны на предположении об отсутствии валентного ГЭП на ядрах-зондах. Эффективные заряды дают представление о валентных состояниях ионов в узлах решетки и о существенных отклонениях от стандартных валентных состояний.

Система уравнений для определения e_{k}^{*} в решетках RBaCuO (где k составляет от 1 до 8 и соответствует подрешеткам R, Ba, Cu(1), Cu(2), O(1), O(2), O(3) и O(4)) должна включать экспериментальные данные, относящиеся только к зондам, для которых выполняется условие (2). Такими кристаллическими зондами для соединений RBaCuO являются ¹¹¹Cd²⁺ в узлах иттрия решетки YBaCuO (возмущенные угловые корреляции (ВУК) ¹¹¹In(¹¹¹Cd) [12]), ¹⁵⁵Gd³⁺ в узлах гадолиния решетки GdBa₂Cu₃O₇ (мессбауэровская спектроскопия ¹⁵⁵Gd [11]), ¹⁵⁵Gd³⁺ в узлах РЗМ решеток RBaCuO (ЭМС ¹⁵⁵Eu(¹⁵⁵Gd)[13]), ¹³³Cs⁺ в узлах Рэм решеток Квасио (Эмс (ЭМС [1] и ВУК [14] ¹³³Ba(¹³³Cs)), ¹³⁷Ba²⁺ в узлах бария решетки УВаСиО (ЯКР и ЯМР ¹³⁷Ba [15]), ⁶⁷Zn²⁺ в узлах меди решеток RBaCuO (ЭМС ⁶⁷Cu(⁶⁷Zn) [16]), ⁶⁷Zn²⁺ в узлах РЗМ решеток RBaCuO (ЭМС ⁶⁷Ga(⁶⁷Zn) [17]). Возможно также использовать в предлагаемой системе уравнений данные ЯМР ¹⁷О для YBaCuO [18]: как показано в [1], условие (2) выполняется и для некоторых кристаллографических позиций кислорода в YBaCuO.

Решения были получены нами для всех возможных наборов предложенной системы уравнений, использующих экспериментальные параметры, обсужденные выше. Особо следует остановиться на ориентации осей тензора кристаллического ГЭП

для узлов Cu(1). Для них с помощью ЭМС ⁶⁷Cu(⁶⁷Zn) [1] установлено, что $Y_{zz3} > 0$ и $\eta_3 \approx 1$. Первое из этих соотношений требует, чтобы z ось тензора кристаллического ГЭП совпадала с кристаллографической осью **a** ($z \parallel a$), а второе, — чтобы отношение e_8^*/e_5^* было близко либо к 0.5 (область решений A, где $x \parallel b$ и $y \parallel c$), либо к 2 (область решений B, где $x \parallel c$ и $y \parallel b$).

При анализе полученных решений мы отбрасывали как не имеющие физического смысла те из них, которые дают отрицательные заряды катионов или положительные ионов кислорода. Оставшиеся решения образуют две группы A и B, соответствующие упомянутым выше областям A и B для разрешенных значений e_8^*/e_5^* . Внутри этих групп решения достаточно близки друг к другу и слабо зависят от того, данные для каких из кристаллических зондов использовались при составлении системы уравнений. Типичные решения приведены в таблице.

Решения, относящиеся к области *B*, приводят к ряду результатов, противоречащих экспериментальным данным: для узлов Ва в YBaCuO расчет дает $z \parallel b$, в то время как, согласно [15], $z \parallel c$; для узлов Gd в GdBa₂Cu₃O₇ расчет дает $z \parallel a$, а согласно данным [11], $z \parallel c$; квадрупольное расщепление для зондов ⁶⁷Zn²⁺ и ¹⁵⁵Gd³⁺ в узлах P3M, по данным ЭМС ⁶⁷Ga(⁶⁷Zn) [17] и ¹⁵⁵Eu(¹⁵⁵Gd) [13], возрастает в ряду RBaCuO с увеличением радиуса ионов P3M, в то время как расчет для моделей типа *B* предсказывает его уменьшение; для узлов R параметр асимметрии тензора кристаллического ГЭП имеет различные зависимости от радиуса ионов P3M для моделей *A* и *B*, а экспериментальные значения η (данные ЭМС ⁶⁷Ga(⁶⁷Zn) [17]) согласуются со значениями, рассчитанными по модели *A*.

Упомянутые выше экспериментальные данные находятся при этом в хорошем согласии с расчетами, сделанными для решений А. Эти решения соответствуют стандартным степеням окисления ионов во всех узлах, кроме цепочечного кислорода O(4), пониженный заряд которого может рассматриваться как проявление дырки в энергетической зоне, образованной преимущественно электронными состояниями O(4).

Достоинством модели точечных зарядов является наглядность получаемых результатов. Так, решения типа *А* для RBaCuO (см. таблицу) обнаруживают две важные особенности. Первая — не заложенное в уравнения соотношение

Эффективные заряды атомов e_k^* (в единицах заряда электрона), полученные путем решения системы уравнений для YBa₂Cu₃O₇, и величины de_k^*/dT (в единицах $10^{-6}e/K$) для модели A

Модель	e_2^*	e_3^*	e_4^*	e_5^*	e_6^*	e_7^*	e_8^*
A B	2.06 3.59	1.88 1.36	1.91 1.49	-1.99 -1.55	-1.91 -2.11	-1.87 -1.99	$-1.27 \\ -3.18$
Модель	de_3^*/d	$T de^{*}_{2}$	d/dT	de_5^*/dT	de_6^*/dT	de_7^*/dT	de_8^*/dT
A	53	3	11	-138	-83	-89	-53

П р и м е ч а н и е. ЁСистемы уравнений составлены с экспериментальными данными ЭМС 67 Си(67 Zn) в узлах Сu(1) и Cu(2) и ЯМР 17 О в узлах O(1) и O(2) (модель A), O(3) и O(4) (модель B). Использованы значения экспериментальных параметров, приведенные в [1,18].



Рис. 1. Экспериментальные (данные BУК ¹¹¹Cd [12]) (точки) и расчетные (сплошные линии) температурные зависимости постоянной квадрупольного взаимодействия |C(Cd)| (*a*) и параметра асимметрии η_1 (*b*) для зонда ¹¹¹Cd²⁺ в узлах иттрия решетки YBaCuO. Расчет проводился для модели *A*.

 $e_1^*:e_2^*=3:2$, что равно отношению единственно возможных валентностей РЗМ и бария. Другая особенность состоит в том, что заряды атомов Cu(1) и Cu(2) соответствуют традиционной валентности меди +2, что также не закладывалось в уравнения. По-видимому, можно считать установленным, что вся известная к настоящему времени совокупность данных по мессбауэровской спектроскопии, ЯКР, ЯМР и ВУК хорошо описывается моделями типа *A* для распределения зарядов в решетках RBaCuO.

В литературе имеются данные по температурной зависимости параметров тензора ГЭП в катионных узлах решетки УВаСиО: по температурным зависимостям постоянной квадрупольного вазимодействия C(Cd) и параметра асимметрии η_1 , измеренным в узлах Y методом возмущенных угловых корреляций на зонде ¹¹¹Cd²⁺ [12]; по температурной зависимости частоты ЯКР ν_2 , измеренной на зонде ¹³⁷Ba²⁺ в узлах Ba [15]; по температурной зависимости частот ЯКР, измеренной на зонде ⁶³Cu²⁺ в узлах Cu(1) (ν_3) и Cu(2) (ν_4) [19].

Используя модели распределения зарядов по узлам решетки, коэффициенты Штернхеймера зондов [20] и температурные зависимости постоянных решетки YBaCuO [21], мы провели количественное сопоставление экспериментальных и расчетных температурных зависимостей параметров тензоров ГЭП. Как видно из рис. 1–3, удовлетворительное согласие имеет место только для частоты ЯКР для зонда 63 Cu²⁺ в узлах Cu(1) и для параметра асимметрии для зонда 111 Cd²⁺. В остальных случаях такое согласие отсутствует. Очевидной причиной расхождения являются неучтенные температурные зависимости эффективных зарядов атомов de_k^*/dT . Последние были определены с использованием уравнения электронейтральности, уравнения для температурной зависимости постоян-





Рис. 2. Экспериментальные (данные ЯМР ¹³⁷Ва [15]) (точки) и расчетные (сплошные линии) температурные зависимости частоты ЯКР ν_2 зонда ¹³⁷Ва²⁺ в узлах бария решетки YBaCuO. Расчет проводился для модели *А*.

Рис. 3. Экспериментальные (данные ЯМР 63 Cu [19]) (точки) и расчетные (сплошные линии) температурные зависимости частоты ЯКР зонда 63 Cu²⁺ в узлах Cu(1) (*a*) и Cu(2) (*b*) решетки YBaCuO. Расчет проводился для модели *A*.

2121

ной квадрупольного взаимодействия зонда ¹¹¹Cd²⁺ в узлах *Y*, уравнения для температурной зависимости частоты ЯКР зонда ¹³⁷Ba²⁺, уравнения для температурной зависимости частоты ЯКР зонда ⁶³Cu²⁺ в узлах Cu(1), уравнения для температурной зависимости частоты ЯКР зонда ⁶³Cu²⁺ в узлах Cu(2).

Поскольку из полученных шести уравнений невозможно определить восемь температурных коэффициентов de_k^*/dT , мы уменьшили число неизвестных, предположив, что заряды атомов Y и Ba не зависят от температуры (поскольку состояния, образованные валентными электронами этих атомов, лежат вдали от уровня Ферми). В таблице приведены решения предложенной системы уравнений, полученные с использованием модели A. Видно, что с повышением температуры концентрация дырок в кислородных подрешетках возрастает.

3. Эффективные заряды атомов решеток TIBaCaCuO и BiSrCaCuO

Для соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO число доступных экспериментальных параметров значительно уступает числу определяемых зарядов. Объясняется это в первую очередь высокой степенью дефектности даже материалов с высокими значениями температуры перехода в сверхпроводящее состояние, что приводит к невоспроизводимости экспериментальных результатов, полученных для номинально тождественных соединений разными группами исследователей.

Именно поэтому для указанных соединений мы воспользовались корреляционным соотношением между C(Zn) и C(Cu) (рис. 4, *a*): для двухвалентных соединений меди экспериментальные данные укладываются на прямую

$$C(Cu) = 197 - 11.3C(Zn)$$
(3)

(где C(Cu) и C(Zn) даны в MHz), а основная причина отклонения от прямой (3) — отличие валентности меди от +2 [22]. Дополнительную информацию можно получить из диаграммы $C(Cu) - V_{zz}$ (рис. 4, *b*, *c*), которая описывается выражением

$$C(\mathrm{Cu}) = 179 - 191.4V_{zz} \tag{4}$$

(где C(Cu) дана в MHz, а Y_{zz} в $e/Å^3$), причем для диаграммы $C(Cu) - V_{zz}$ существует еще одна причина отклонения от прямой (4) — неправильный расчет тензора ГЭП из-за несовершенства выбора зарядов ионов [22]. Поэтому положение точек на диаграммах C(Cu) - C(Zn) и $C(Cu) - V_{zz}$, отвечающих одинаковой позиции меди, можно использовать для отбора возможных вариантов распределения зарядов в решетках.

Данные ЯКР ⁶³Си для соединений ТІВаСаСиО [2] и ВіSrCaCuO [4] вместе с нашими данными ЭМС ⁶⁷Cu(⁶⁷Zn) приведены на диаграмме C(Cu) - C(Zn) (рис. 4, *a*). Поскольку метод ЯКР не позволяет определять знак C(Cu), мы определили знаки C(Cu) по соотношению (3). Видно, что все точки удовлетворительно соответствуют соотношению (3), т.е. медь в соединениях ТІВаСаСиО и ВіSrCaCuO двухвалентна.

Не наблюдается согласия данных [2,4] с линейной зависимостью (4) на диаграмме $C(\text{Cu}) - V_{zz}$ (рис. 4, *c*), если расчет V_{zz} проводился для моделей *A* (эта модель предполагала стандартные степени окисления всех атомов: Tl^{3+} , Bi^{3+} , Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} , Cu^{2+} , O^{2-}). Отклонения от линейной зависимости (4) следует объяснить несовершенством выбора модели для расчета V_{zz} . Для согласования данных с зависимостью (4) необходимо локализовать дырки на атомах кислорода, находящихся в одной плоскости с атомами Cu(2). Для соединения TlBaCaCuO дырки могут появиться за счет стабилизации части атомов таллия в одновалентном состоянии. В пользу такого предположения свидетельствуют, в частности, данные ЯМР ²⁰⁵Tl [23]. Из рис. 4, *с* видно, что для модели *B*, учитывающей появление дырок на атомах кислорода, наблюдается удовлетворительное согласие с линейной зависимостью (4) (в модели *B* предполагалось, что 12.5% атомов таллия находятся в одновалентном состоянии).

Для соединения BiSrCaCuO дырки могут появиться за счет ионов свинца Pb²⁺, понижающих средний заряд подрешетки Bi. Если считать, что все атомы свинца двухваленты, то на один узел кислорода в плоскости Cu(2)–О приходится 0.1 дырки. Однако такой концентрации дырок недостаточно для перемещения точки Cu(2) на прямую (4). Последнее достигается для модели *B*, которая отвечает 0.2 дырки на узел кислорода в плоскости Cu(2)–О. Эта модель требует дополнительных источников дырок в решетке BiSrCaCuO. Такими источниками могут быть, в частности, структурные дефекты, высокая концентрация которых характерна для этого соединения. Поскольку природа этих дефектов неизвестна, при расчетах тензора ГЭП в модели *B* предполагалось, что наряду с атомами свинца еще и 20% атомов висмута двухвалентны.

Имеются и другие данные ЯКР ⁶³Cu для соединений TIBaCaCuO [3] и BaSrCaCuO [3,5–7], существенно отличающиеся от данных [2] и [4]. Как видно из рис. 4, *a*, данные [3,5–7] оставляют точку Cu(2) на прямой (3) (т.е. нет сомнений в двухвалентности Cu(2) в TIBaCaCuO и BiSrCaCuO), но приводят к отклонению точки Cu(1) вниз от прямой (3) для обоих соединений. Такое отклонение следует интерпретировать как пониженное значение валентности вклада в C(Cu), и его можно связать с частичным заполнением дырки 3*d*-оболочки Cu(1). Если исходить из того, что валентный вклад пропорционален числу 3*d*-дырок и равен 197 MHz для иона с одной



Рис. 4. Диаграммы C(Cu) - C(Zn) (*a*) и $C(Cu) - V_{zz}$ (*b*, *c*) для соединений двухвалентной меди (сплошные прямые). Точками представлены данные: 1 — TIBaCaCuO [2], 2 — BiSrCaCuO [4], 3 — TIBaCaCuO [3], 4–7 — BiSrCaCuO [3], [7], [5] и [6] соответственно. Индексы *A*, *B*, и *C* обозначают модели расчета V_{zz} . Ссылки относятся к данным ЯКР ⁶³Си.

3*d*-дыркой [22], то имеющееся отклонение от прямой (3) соответствует заряду атомов Cu(1) + 1.8e в решетке TlBaCaCuO и от +1.85e до +1.7e в решетке BiSrCaCuO. Таким образом, авторы [3,5–7] использовали образцы TlBaCaCuO и BiSrCaCuO с частично восстановленной медью в положениях Cu(1).

Из рис. 4, b видно, что использование моделей А и данных [3,5-7] приводит к отклонению от прямой (4) как точки Cu(1), так и точки Cu(2) для обоих соединений. Отклонение точки Cu(1) объясняется уже обсуждавшимся выше отличием валентности меди в этих узлах от +2. Оклонение точки Cu(2) следует по-прежнему связывать с неправильно рассчитанным кристаллическим ГЭП из-за неправильного выбора модели распределения зарядов в решетке, т.е. следует локализовать дырки на узлах кислорода, находящихся в одной плоскости с атомами Cu(2). Однако при использовании экспериментальных данных [3,5-7] возникает дополнительный источинк дырок на узлах кислорода: за счет понижения заряда Cu(1). В частности, если принять, что заряд Cu(1) в TlBaCaCuO равен +1.8e и появляющиеся в результате этого дырки локализованы в подрешетке O(2), то точка Cu(2) попадает на прямую (4) (модель C на рис. 4, b). Аналогично, если принять, что заряд Cu(1) в BiSrCaCuO равен +1.75*e*, все атомы свинца двухваленты и появляющиеся в результате этого дырки локализованы в подрешетках O(2) и O(3), то точка Cu(2) попадает на прямую (4) (модель C на рис. 4, b).

4. Сопоставление с процессами переноса

Для всех исследованных соединений на кислородные подрешетки приходится дефицит отрицательного заряда. В решетках RBaCuO этот дефицит (дырка) находится преимущественно на цепочечном кислороде (~60%) (см. таблицу) и частично (~30%) на плоскостных атомах кислорода. В решетках TIBaCaCuO и BiSrCaCuO дырки находятся на кислородных узлах, находящихся в одной плоскости с атомами Cu(2). Эти дырки следует рассматривать не как локализованные на отдельных кислородных узлах, а как дырки в зонах делокализованных состояний, происходящих от электронных состояний соответствующих подрешеток. В противном случае атомы-зонды в различных узлах одной и той же катионной подрешетки имели бы в своем ближайшем окружении ионы кислорода с различными зарядами, что приводило бы к расщеплению ЯКР и мессбауэровских спектров на несколько составляющих.

Естественно сопоставить дефицит электронов на узлах O(2) и O(3) с дырками в плоскости CuO_2 , которые обеспечивают электропроводность соединений RBaCuO по крайней мере в нормальном состоянии. Концентрация последних определена из эффекта Холла и для YBaCuO при 100 К составляет ~ 0.35 дырки на элементарную ячейку, что хорошо согласуется с полученной нами оценкой. Дырки на цепочечном кислороде, хотя и имеют большую концентрацию, вносят, по-видимому, малый вклад в электропроводность из-за их существенно меньшей подвижности. Иначе наблюдалась бы анизотропия проводимости в плоскости *ab*. Отметим, что, согласно полученным результатам, с повышением температуры концентрация дырок в кислородных подрешетках YBaCuO возрастает. Это находится в качественном согласии с результатами измерений температурной зависимости холловской концентрации носителей.

Оценки, сделанные для соединений TlBaCaCuO и BiSrCaCuO, указывают на наличие 0.15-0.2 дырки на

кислородных узлах в плоскости Cu(2)–O, что качественно согласуется с холловскими данными. Эти же данные указывают на возможное понижение валентности меди из слоев, расположенных между слоями кальция.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 97-02-26216) и Конкурсным центром фундаментального естествознания при Санкт-Петербургском государственном университете (проект 95-0-7.0-80).

Список литературы

- [1] Ф.С. Насрединов, В.Ф. Мастеров, Н.П. Серегин, П.П. Серегин. ЖЭТФ **99**, 1027 (1991).
- [2] Ю.И. Жданов, А.М. Богданович, К.Н. Михалев, Б.А. Алексашин, В.В. Лаврентьев, С.В. Верховский, А.И. Акимов, А.П. Чернякова. СФХТ 6, 750 (1993).
- [3] T. Oashi, K. Kumagai, H. Nakajima, M. Kikuchi, Y. Syono. Physica C161, 367 (1989).
- [4] B.W. Statt, L.M. Song. Physica C183, 372 (1991).
- [5] H. Lutgemeier. Hyperfine Interact. 61, 1051 (1990).
- [6] K. Fujiwara, Y. Kitaoka, K. Asayama, H. Sasakura, S. Minamigawa, K. Nakahigashi, S. Nakanishi, M. Kogachi, N. Fukuoka, A. Yanase. J. Phys. Soc. Jap. 58, 380 (1989).
- [7] H. Riesemeier, G. Stadermann, H. Kamphausen, K. Luders, C. Politis, V. Muller. J. Less-Comm. Met. 164/165, 1106 (1990).
- [8] J.M. Tarascon, W.R. McKinnon, L.H. Greene, G.W. Hull, E.M. Vogel. Phys. Rev. B36, 226 (1987); Y. LePage, T. Siegrist, S.A. Sunshine, L.F. Schneemeyer, D.W. Murphy, S.M. Zahurak, J.V. Waszczak, W.R. McKinnon, J.M. Tarascon, G.W. Hull, L.H. Greene. Phys. Rev. B36, 3617 (1987).
- [9] K. Yvon, M. Francois. Z. Phys. B76, 413 (1989).
- [10] W. Carrilo-Cabrero, W. Gopel. Physica C191, 373 (1989).
- [11] G. Wortmann, A. Kolodziejczyk, M. Bergold, G. Stadermann, C.T. Simmons, G. Kaindl. Hyperfine Interact. 50, 555 (1989).
- [12] H. Plank, F. Meyer, W. Witthuhn. Phys. Lett. A133, 451 (1988).
- [13] П.П. Серегин, В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, Ч.С. Саидов, Е.А. Томильцев. ФТТ 35, 8, 2179 (1993).
- [14] W. Troger, P. Vulliet, J.P. Senateur, F. Weiss, T. Butz, A. Lerf. Hyperfine Interact. 61, 1151 (1990).
- [15] А.В. Егоров, Г. Краббес, Г. Лютгемейер, А.Ю. Якубовский. СФХТ 5, 1231 (1992).
- [16] V.F. Masterov, F.S. Nasredinov, N.P. Seregin, P.P. Seregin, M.A. Sagatov. J. Phys.: Condens. Matter, 7, 2345 (1995).
- [17] В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, Н.П. Серегин, П.П. Серегин. ФТТ 38, 7, 1986 (1996).
- [18] M. Takigawa, P.C. Hammel. R.H. Heffner. Z. Fisk, K.C. Ott, J.D. Thompson. Phys. Rev. Lett. 63, 1865 (1989).
- [19] D. Brinkmann. Naturforsch. A45, 393.
- [20] П.П. Серегин, В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, Н.П. Серегин, Ч.С. Саидов, К.Х. Бабамуратов. ФТТ 36, 3, 769 (1994).
- [21] M. Francois, A. Junod, K. Yvon, A.W. Hewat, J.J. Capponi, P. Strobel, M. Marezio, P. Fischer. Solid State Commun. 66, 1117 (1988).
- [22] В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, Н.П. Серегин, П.П. Серегин, С.М. Иркаев. ФТТ 37, 11, 3400 (1995).
- [23] Ю.И. Жданов, К.Н. Михалев, Б.А. Алексашин, С.В. Верховский, К.А. Окулова, В.И. Воронин, Л.Д. Шустов, А.Ю. Якубовский, А.И. Акимов. СФХТ 3, 194 (1990).